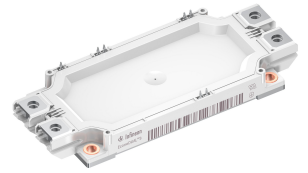


EconoDUAL™3 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 750\text{ A} / I_{CRM} = 1500\text{ A}$
 - Integrierter Temperatursensor
 - Trenchstop™ IGBT7
 - V_{CESat} mit positivem Temperaturkoeffizienten
- Mechanische Eigenschaften
 - PressFIT Verbindungstechnik
 - Standardgehäuse
 - Isolierte Bodenplatte
 - Hohe Leistungsdichte



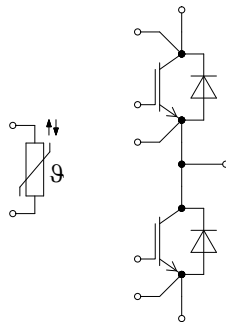
Potenzielle Anwendungen

- Hybrid-Nutzfahrzeuge
- Hochleistungsumrichter
- Motorantriebe
- Servoumrichter
- USV-Systeme

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, Wechselrichter	3
3	Diode, Wechselrichter	5
4	NTC-Widerstand	6
5	Kennlinien	7
6	Schaltplan	12
7	Gehäuseabmessungen	13
8	Modul-Label-Code	14
	Änderungshistorie	15
	Disclaimer	16

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.4	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	15.0	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	13.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	12.5	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	10.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	RTI	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{SCE}			20		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		0.8		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift M5, Schraube	3		6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift M6, Schraube	3		6	Nm
Gewicht	G			345		g

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$	$T_C = 90^\circ\text{C}$	750	A
Grenzeffektivstrom der Modul DC-Kontakte	I_{trms}		$T_{Terminal} = 90^\circ\text{C}$, $T_C = 90^\circ\text{C}$	580	A
			$T_{Terminal} = 105^\circ\text{C}$, $T_C = 90^\circ\text{C}$	565	

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$	1500	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		± 20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE \text{ sat}}$	$I_C = 750 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1.50	1.75	V
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	1.65		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	1.75		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 15 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$	5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CE} = 600 \text{ V}$		12		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		0.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ °C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		115		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ °C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.58		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		45	μA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$			100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 750 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 0.5 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	0.300		μs
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	0.320		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	0.340		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 750 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 0.5 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	0.079		μs
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	0.086		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	0.090		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 750 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 0.5 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	0.470		μs
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	0.550		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	0.600		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 750 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 0.5 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	0.110		μs
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	0.240		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	0.350		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 750 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 25 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 0.5 \Omega, di/dt = 7000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ °C})$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	53		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	86		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	107		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 750\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $L_\sigma = 25\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 0.5\ \Omega$, $dv/dt = 3100\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	65		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	97.5		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	121		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 800\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 8\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$	2900		A
			$t_P \leq 6\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 175\text{ °C}$	2800		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT			0.0520	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		0.0260		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj\ op} > 150\text{ °C}$ ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Dauergleichstrom	I_F		750	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$	1500	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_P = 10\text{ ms}$, $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	A^2s
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 750\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.80	2.10	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.70		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.60		
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_R = 600\text{ V}$, $I_F = 750\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 7000\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	400		A
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	485		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	561		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_R = 600 \text{ V}$, $I_F = 750 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 7000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	48		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	84		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	131		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_R = 600 \text{ V}$, $I_F = 750 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 7000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	20		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	32		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	53		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode			0.101	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		0.0380		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj op}$		-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj op} > 150 \text{ °C}$ ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

4 NTC-Widerstand

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ °C}$, $R_{100} = 493 \text{ Ω}$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K

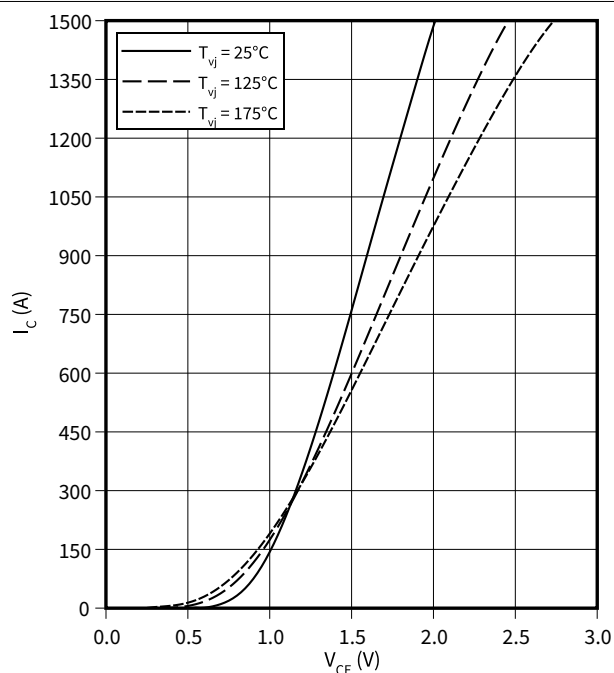
Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

5 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

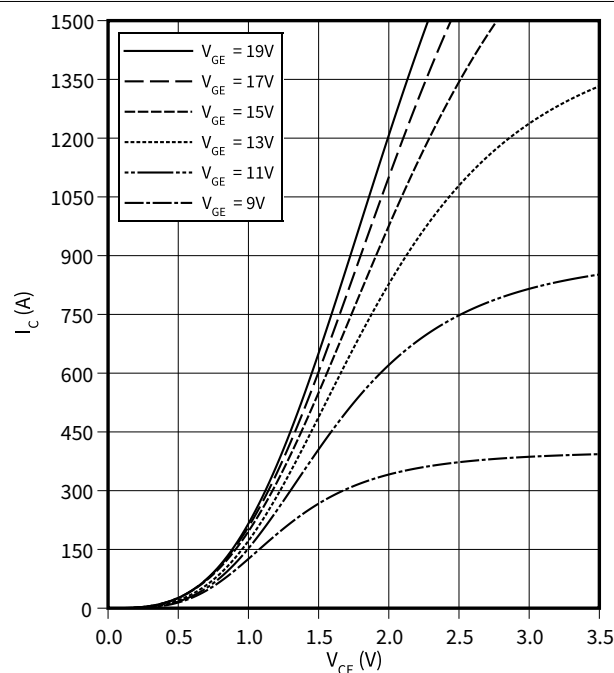
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

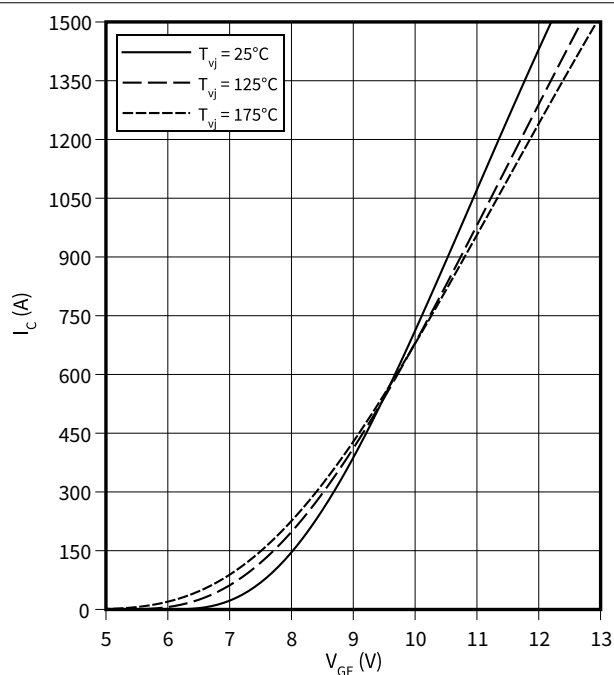
$$T_{vj} = 175 \text{ °C}$$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{GE})$$

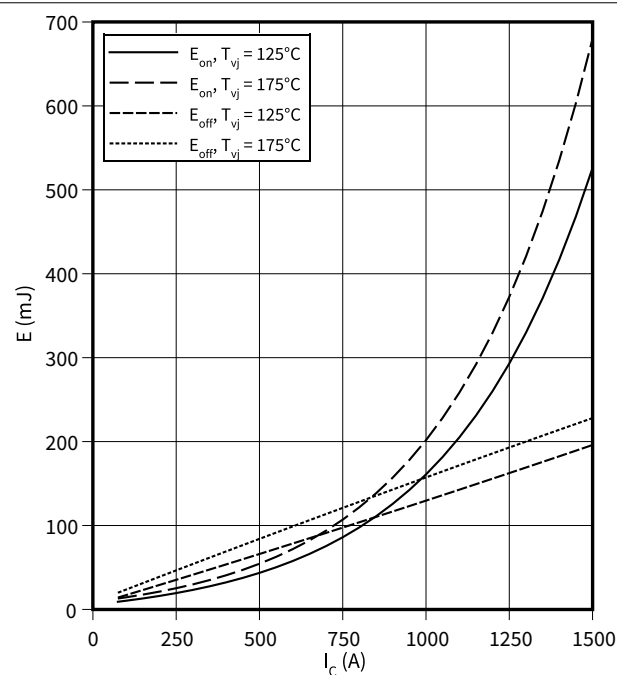
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$E = f(I_C)$$

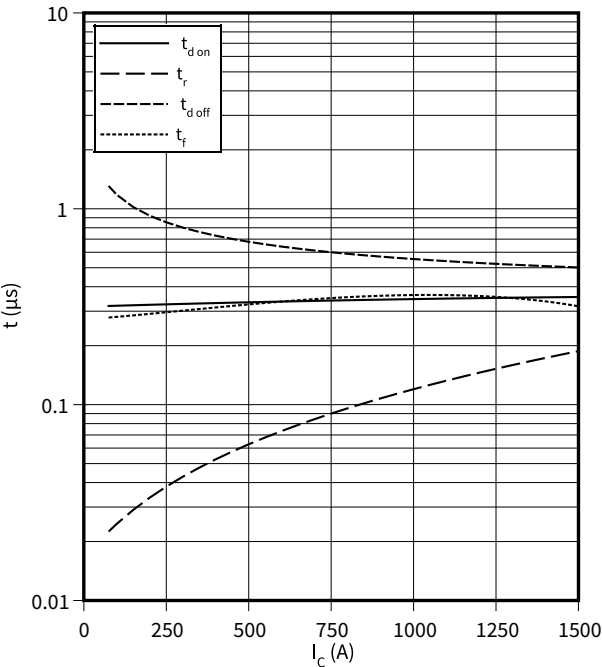
$$R_{Goff} = 0.5 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.5 \text{ } \Omega, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 / 15 \text{ V}$$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$

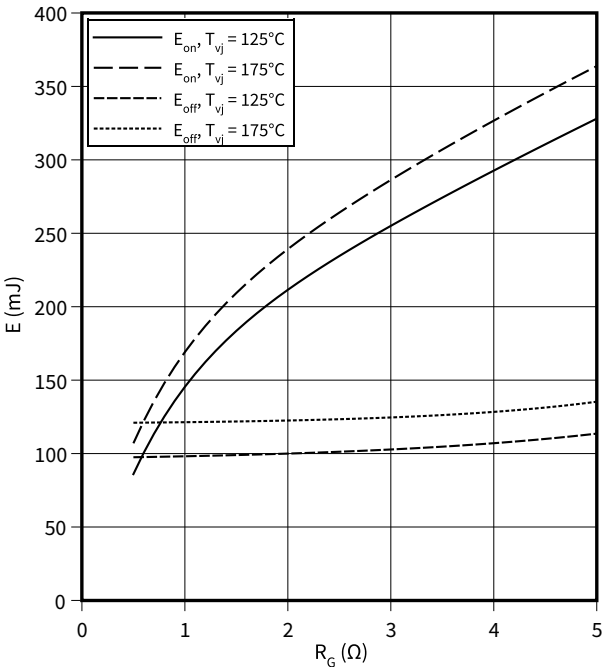
$R_{Goff} = 0.5 \Omega$, $R_{Gon} = 0.5 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

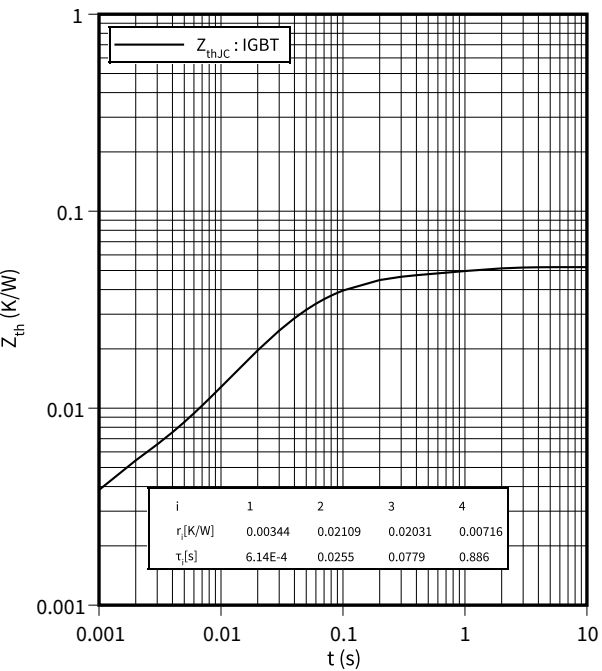
$E = f(R_G)$

$I_C = 750 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 / 15 \text{ V}$



Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter

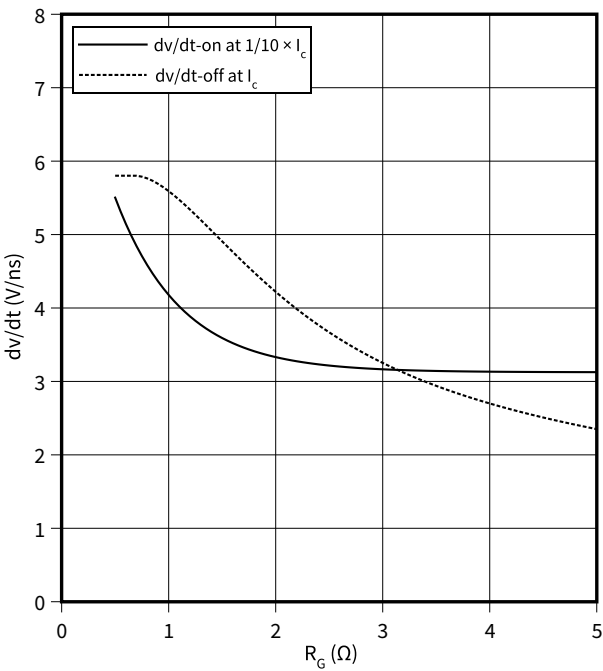
$Z_{th} = f(t)$



Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter

$dv/dt = f(R_G)$

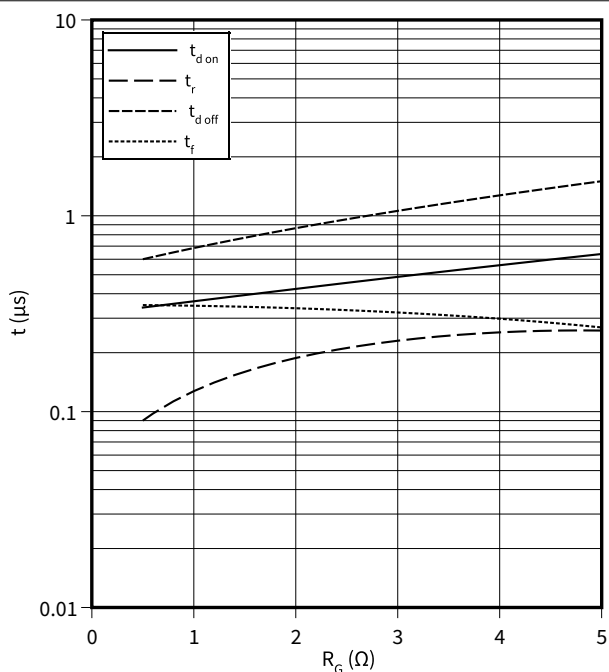
$I_C = 750 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$t = f(R_G)$$

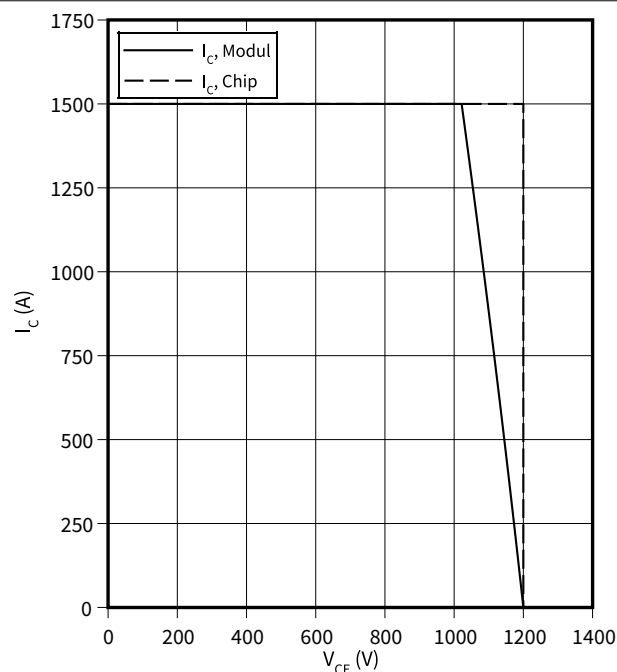
$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 750 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ °C}$$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

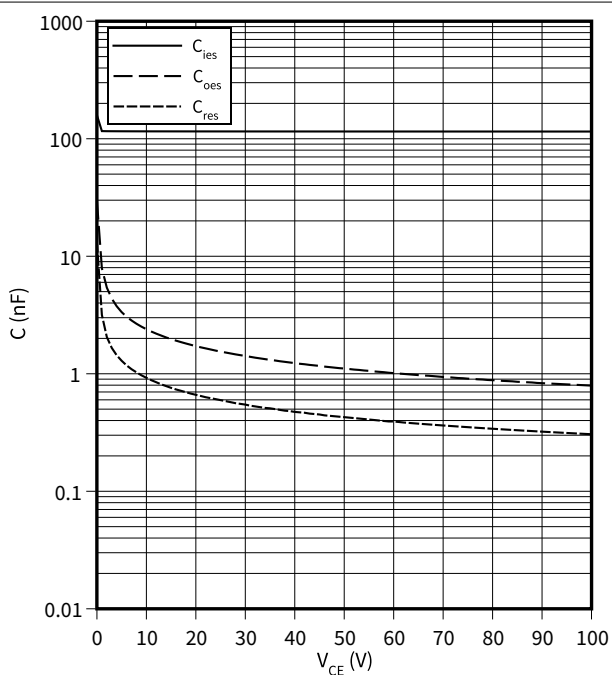
$$R_{Goff} = 0.5 \text{ Ω}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ °C}$$



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$C = f(V_{CE})$$

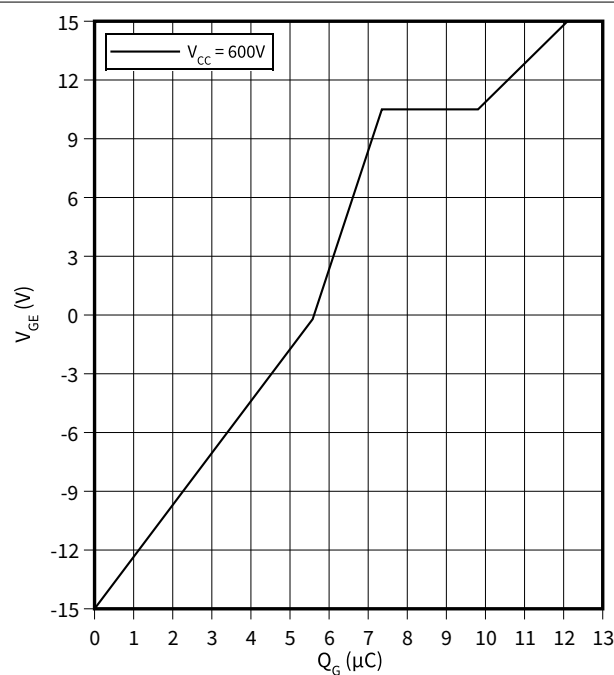
$$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$$



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

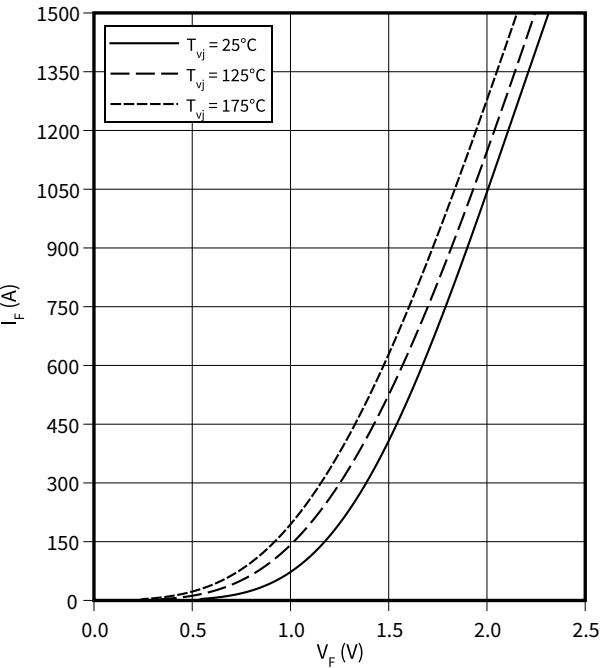
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 750 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$$



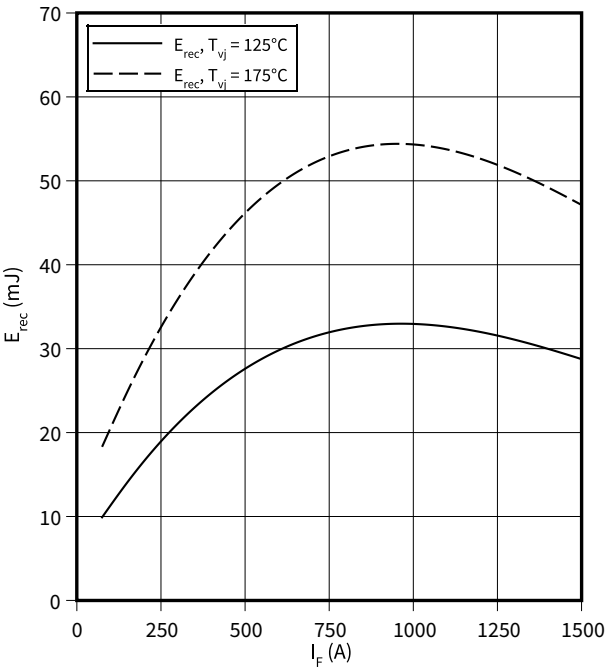
Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Wechselrichter

$I_F = f(V_F)$



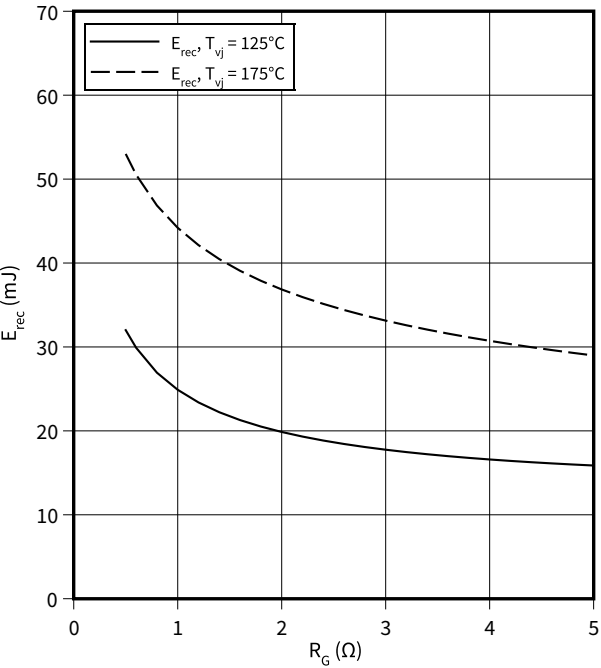
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$
 $V_{CE} = 600\text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(\text{IGBT})$



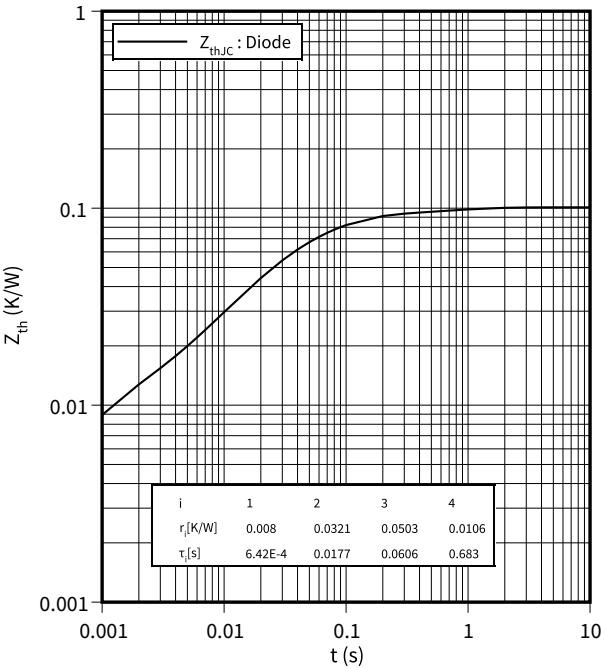
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 600\text{ V}, I_F = 750\text{ A}$



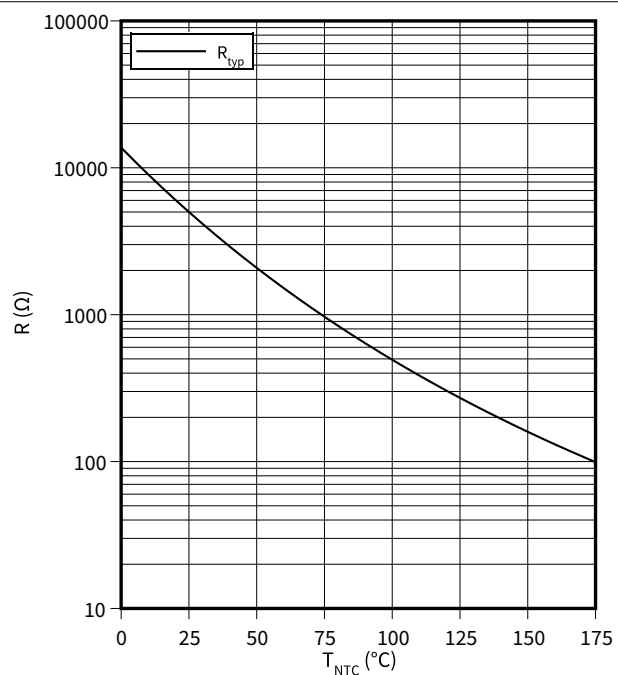
Transienter Wärmewiderstand , Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$$R = f(T_{NTC})$$



6 Schaltplan

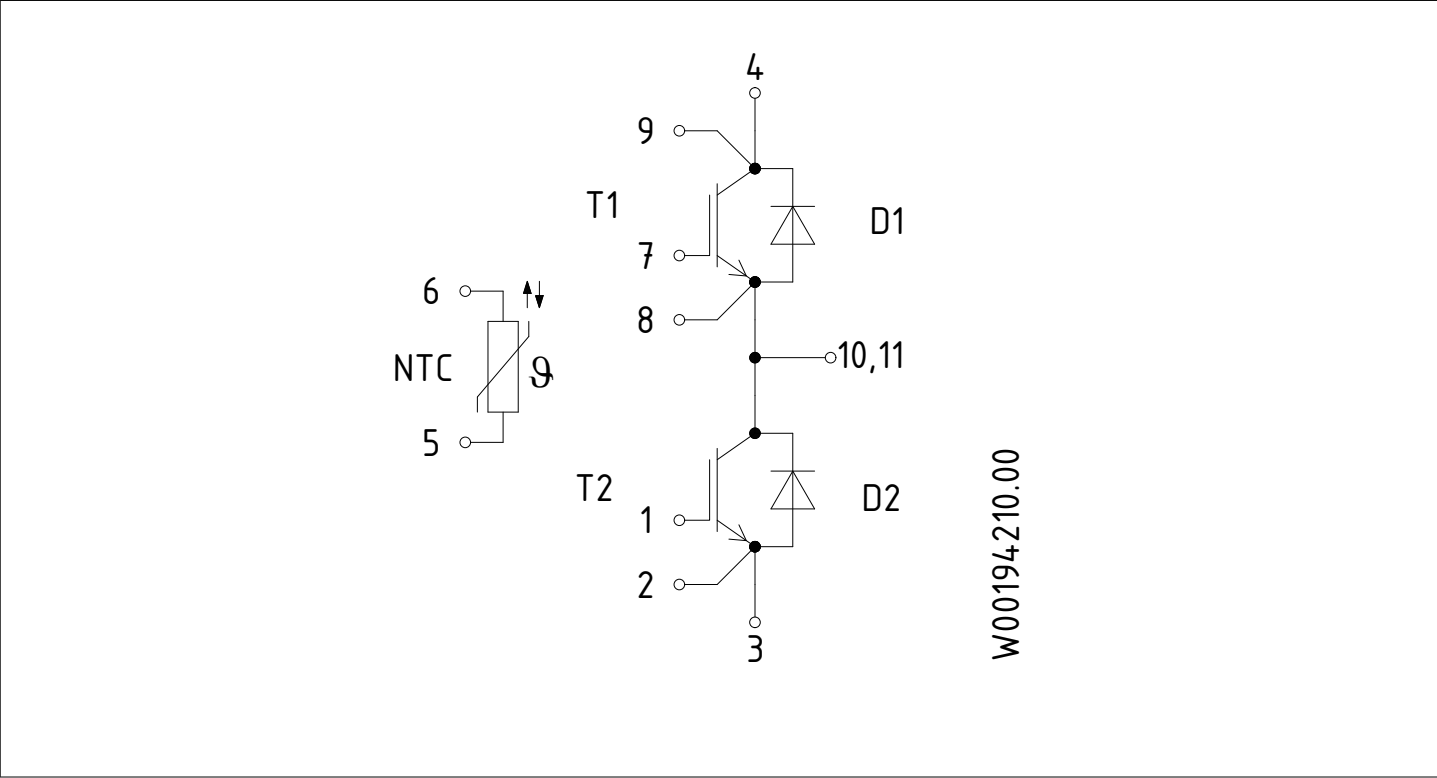


Abbildung 1

7 Gehäuseabmessungen

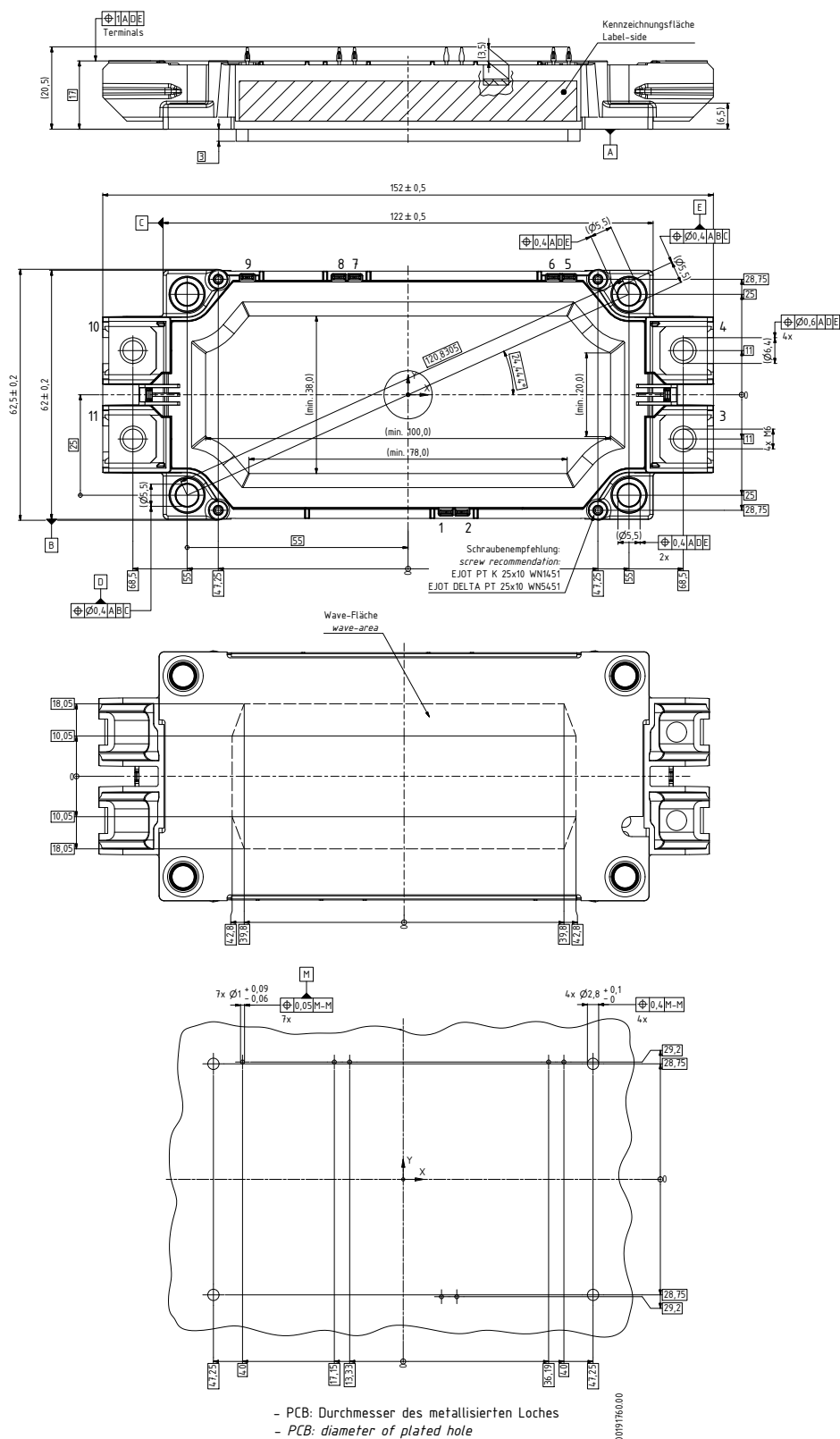


Abbildung 2

8 Modul-Label-Code



Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	<div> 71549142846550549911530</div> <div> 71549142846550549911530</div>		

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
V1.0	2019-11-06	Target datasheet
0.11	2020-11-24	Target datasheet
1.00	2021-05-27	Final datasheet
1.10	2021-10-11	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2021-10-11

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2021 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any
aspect of this document?**

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-AA184-004**

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht gemäß den AEC Q100 oder AEC Q101 Dokumenten des Automotive Electronics Council qualifiziert ist.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.